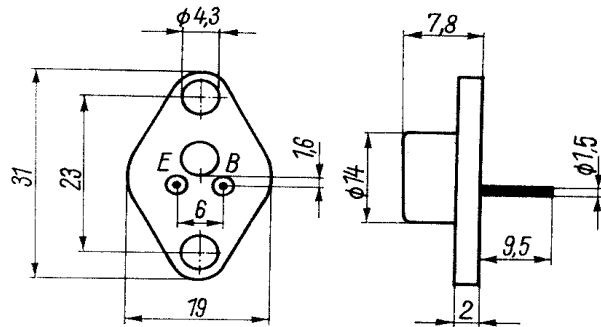


Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11 811 für Verstärker-Endstufen und als Paare für Gegentaktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie für Regel- und Steuerzwecke.



Masse ca. 7,5 g

Wärmewiderstand $R_{thjc} \leq 7,5 \text{ grad/W}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CB0} = 20 \text{ V}$
Kollektor-Emitter-Spannung $R_{BE} = 50 \Omega$	$-U_{CER} = 18 \text{ V}$
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CES} = 20 \text{ V}$
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO} = 10 \text{ V}$
Gesamtverlustleistung	$P_v = 5,3 \text{ W}$
Kollektorstrom	$-I_c = 3,0 \text{ A}$
Emitterstrom	$I_E = 3,6 \text{ A}$
Basisstrom	$-I_B = 0,6 \text{ A}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_j = +85 \text{ °C}$
Betriebstemperaturbereich	$-25 \text{ °C bis } +65 \text{ °C}$

Statische Kennwerte

	Min.	Typ	Max.	
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 6 \text{ V}$		$20 \mu\text{A}$	$50 \mu\text{A}$	
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CE} = 20 \text{ V}$		$400 \mu\text{A}$	$1500 \mu\text{A}$	
Kollektor-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode $-U_{EB} = 1 \text{ V}$ $-U_{CE} = 20 \text{ V}$		$100 \mu\text{A}$	$1000 \mu\text{A}$	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $-I_B = 0,5 \text{ A}$ $-I_c = 3 \text{ A}$		$0,3 \text{ V}$	$0,6 \text{ V}$	
Basis-Emitter-Spannung $-U_{CE} = 6 \text{ V}$ $I_c = 0,2 \text{ A}$		$0,35 \text{ V}$	$0,50 \text{ V}$	Stromverstärkungsgruppe
Basis-Emitter-Spannung $-U_{CE} = 2 \text{ V}$ $-I_c = 1,5 \text{ A}$		$0,75 \text{ V}$	$1,0 \text{ V}$	
Kollektor-Basis-Stromverhältnis $-U_{CE} = 2 \text{ V}$ $-I_c = 1,5 \text{ A}$	h_{21E}	18 28 45	35 56 90	A B C
	h_{21E}	30		
h_{21E} -Verhältnis $-I_c = 1,5 \text{ A}$ $-I_c = 0,2 \text{ A}$ $U_{CE} = 2 \text{ V}$	$\frac{h_{21E} (1,5 \text{ A})}{h_{21E} (0,2 \text{ A})}$	0,5		



		Min.	Typ	Max.	
Paarigkeitsbedingungen					
Verhältnis der Basisströme	$\frac{I_{B1}}{I_{B2}}$	0,833		1,2	
bei					
-U _{CE}	= 6 V				
-I _c	= 0,2 A				
und					
-U _{CE}	= 2 V				
-I _c	= 3 A				
Verhältnis der Basis-Emitter- spannungen	$\frac{U_{BE1}}{U_{BE2}}$	0,833		1,2	
bei					
-U _{CE}	= 2 V				
-I _c	= 3 A				
Dynamischer Kennwert					
Übergangsfrequenz	f _t	180 kHz	250 kHz		A
-U _{CE}	= 6 V	200 kHz	300 kHz		B
-I _c	= 0,3 A	250 kHz	350 kHz		C

Stromverstärkungs-
gruppe

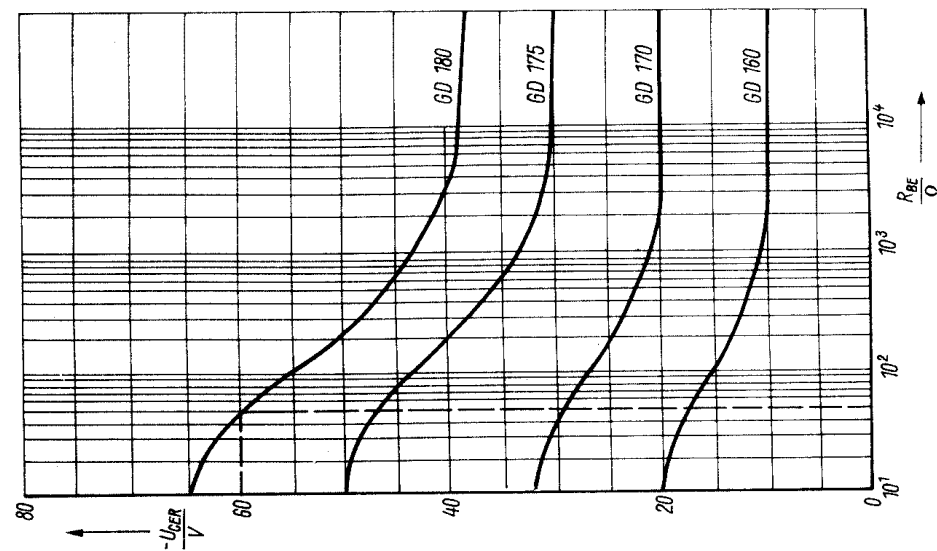
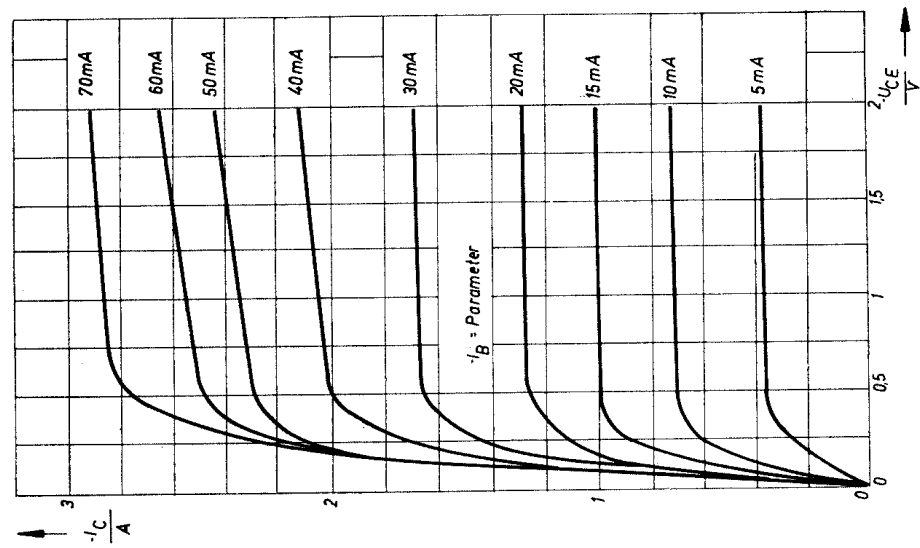
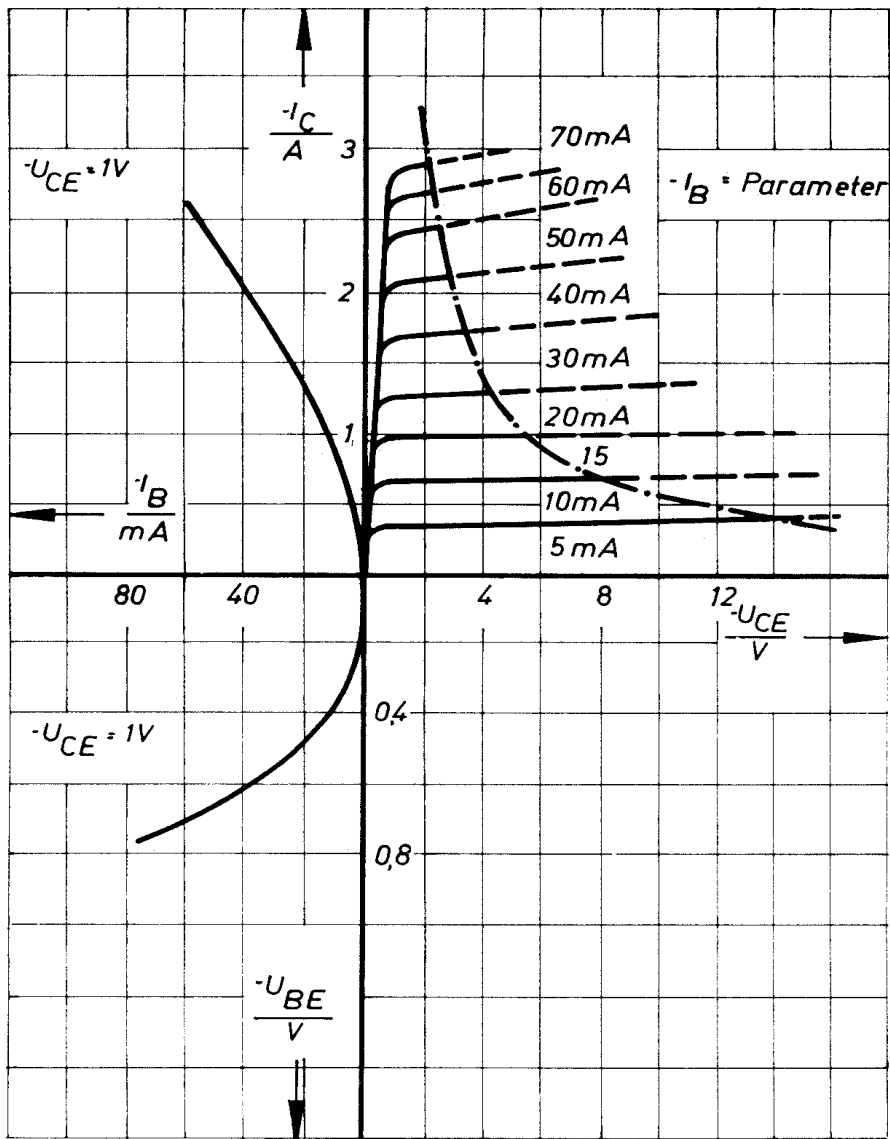
Bestellbeispiel für einen Transistor
der Stromverstärkungsgruppe B

Transistor GD 160 B

Bestellbeispiel für ein Transistorpaar
der Stromverstärkungsgruppe B

Transistorpaar 2 GD 160 B





Kühlfläche Al 2 mm dick, blank, vertikale Lage –
bei isolierter Montage Lackpapier 0,1 mm dick.

- direkte Montage
- - - isolierte Montage
- K = Kühlfläche

